

# Parametry a vlastnosti konkrétních IO

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslerova

Autor: Ing. Pavel Votrubec

Název: VY\_32\_INOVACE\_02\_CIT\_24\_Technologie\_TTL\_S

Téma: Technologie TTL s logickými členy

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036



evropský  
sociální  
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

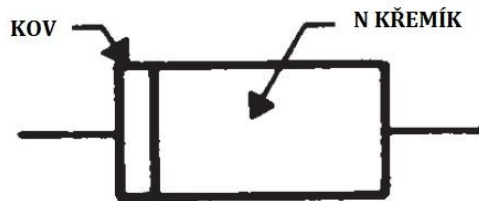
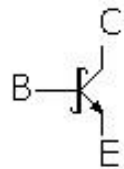
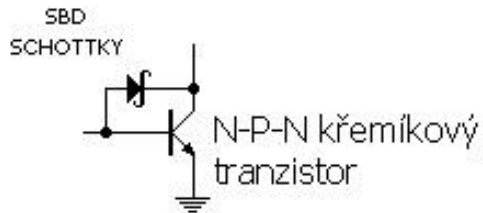


OP Vzdelávání  
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

# Technologie TTL-S

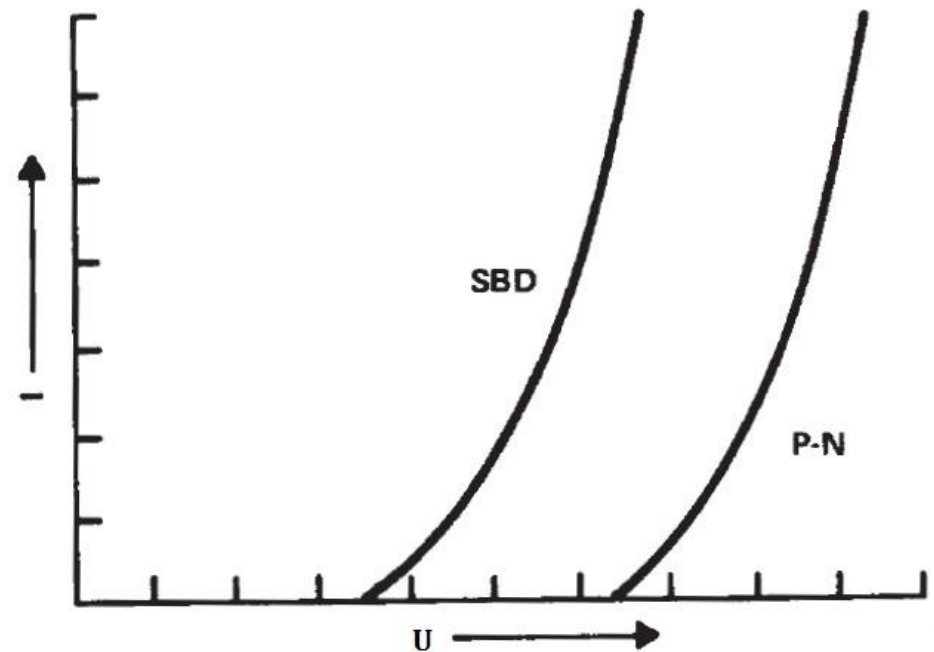
Využití Schottkyho diody (PN přechod polovodič - kov) zabraňuje saturaci křemíkového tranzistoru a tím se spínací doby zkrátí na méně než 1 nsec.



SLOŽENÍ



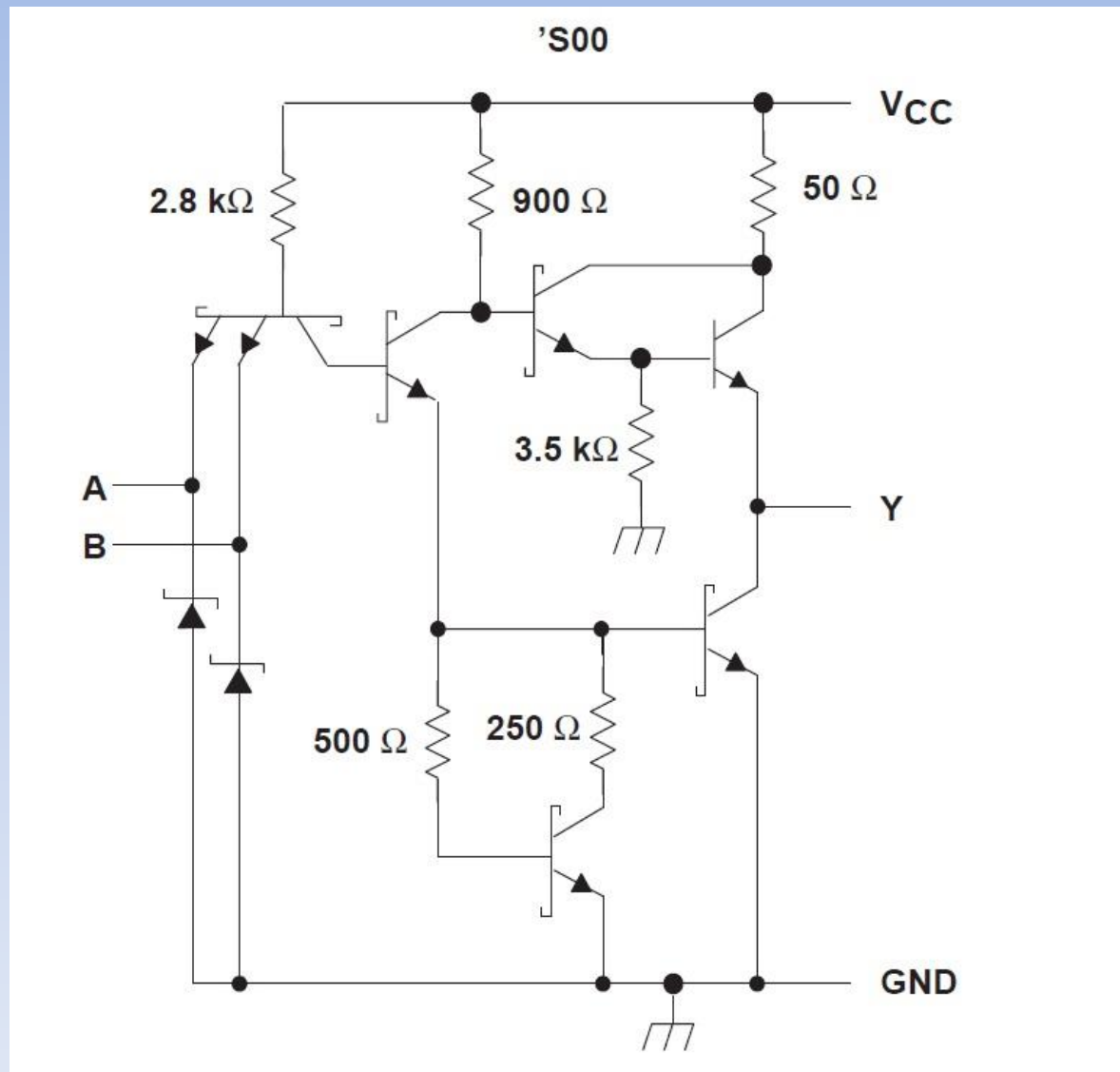
schématická značka



Vstupně-výstupní V-A charakteristiky klasické PN diody a Schottkyho diody (SBD)

Schottkyho dioda (Schottky Barrier-Diode)

# Technologie TTL-S „SN74S00“



Zpoždění průchodu členem se zkrátilo až na 2-4 ns a ukázala se možnost zvýšit pracovní kmitočet až do 100 MHz.

# Technologie ECL – od roku 1962

